

KT845A



БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ HIGH POWER MEDIUM FREQUENCY

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n переключающий транзистор KT845A предназначен для работы в импульсных схемах аппаратуры широкого применения.

Оформление - в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами.

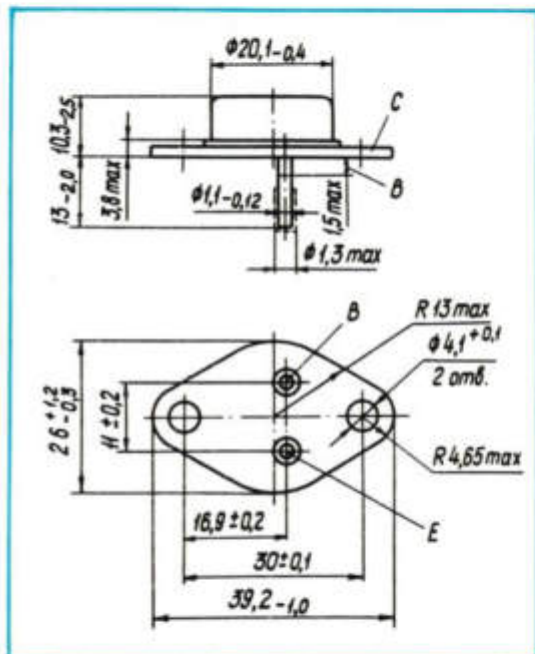
Диапазон допустимых рабочих температур от -45 до 100°C.

GENERAL DESCRIPTION

The KT845A transistors are Silicon planar-epitaxial n-p-n switching-type transistors designed for use in pulse circuits of equipment in a wide range of applications.

The devices are encapsulated in metal cases with glass insulators.

Allowable operating temperatures: -45 to + 100°C.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

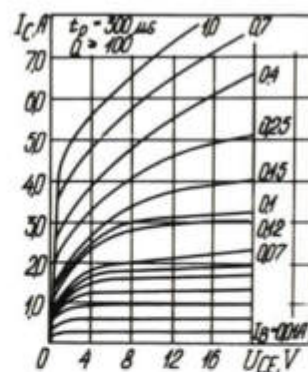
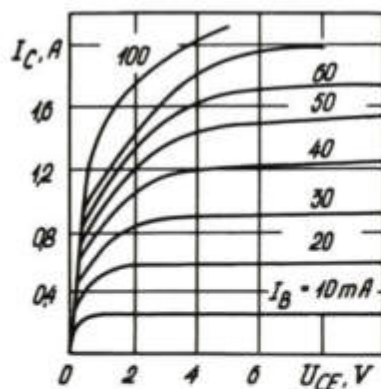
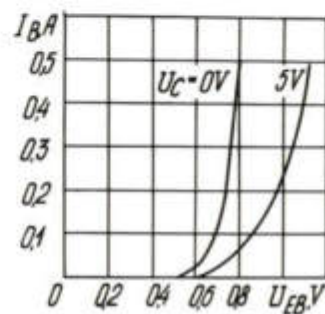
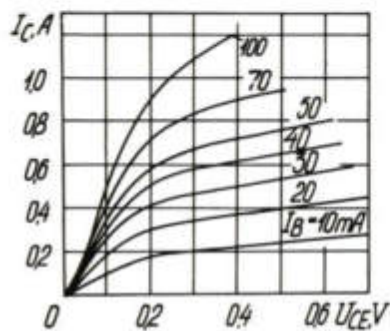
$U_{CER \max}$ ($R_{BE} = 10 \Omega$)	400 V
$U_{CEM \max}$ ($R_{BE} = 10 \Omega$)	400 V
$U_{EB \max}$	4 V
$I_C \max$	5 A
$I_{CM \max}$	7,5 A
$I_B \max$	1,5 A
$I_{BM \max}$	4 A
$P_C \max^*$ ($t_{case} \leq 50^\circ C$)	40 W
$t_j \max$	175°C

* При $t_{case} > 50^\circ C \Rightarrow P_C \max = \frac{t_j \max - t_{case}}{R_{thjc}}$

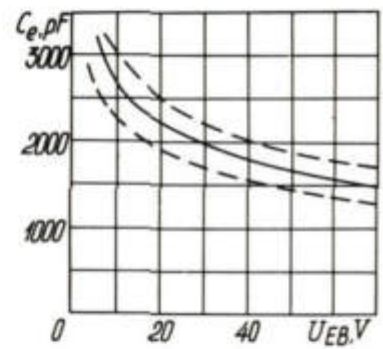
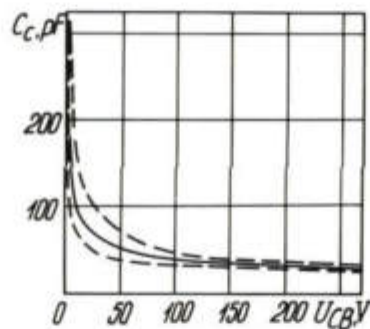
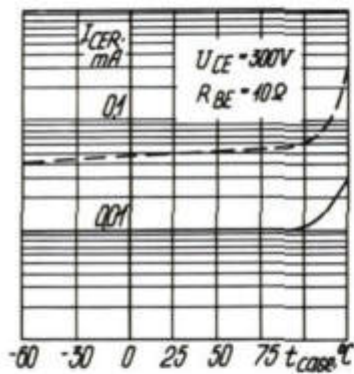
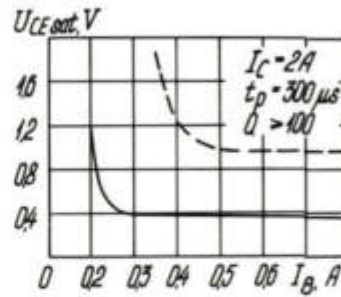
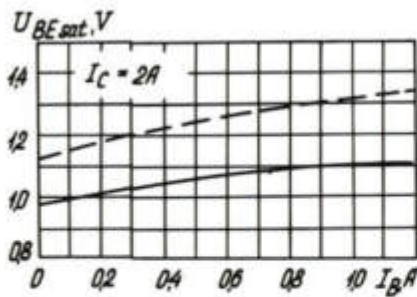
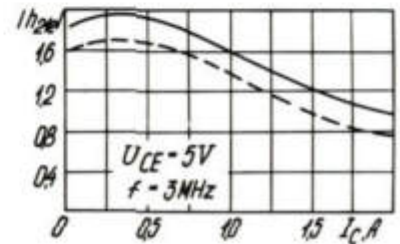
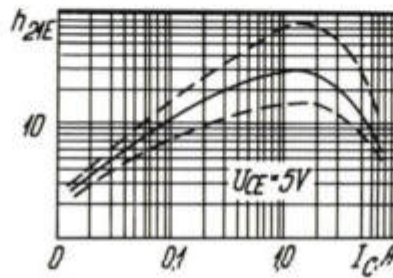
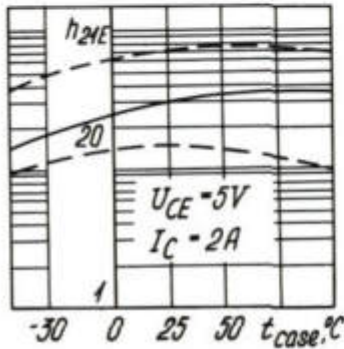
KT845A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions			
		$U_{CE}; U_{CB}^*, V$ U_{EB}^{**}, V	$I_C; I_B^*, A$	R_{BE}, Ω	f, MHz
I_{CER}, mA	< 3	400		10	
I_{EBO}, mA	< 15	4**			
$U_{(L) CEO}, V$	> 400		0,1		
$U_{CE sat}, V$	$< 1,5$		2; 0,4*		
$U_{BE sat}, V$	$< 1,8$		2; 0,4*		
h_{21E}	15 - 100	5	2		
$ h_{21e} $	$> 1,7$	5	0,5		3



KT845A



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF 95% РАЗБРОСА
SPREAD